

ZHEJIANG UNIU-NE Technology CO., LTD 浙江宇力微新能源科技有限公司



V 1.1

版权归浙江宇力微新能源科技有限公司

■ 产品描述

U3210B是一款高性能低成本PWM控制功率器, 适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、 器件个数少。同时产品启动模块内置高耐压(500V) MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。

与传统的 PWM 功率开关不同,U3210B内部无固定时钟驱动 MOSFET ,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式PWM控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。

U3210B集成有完备的带自恢复功能的保护功能: VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、 过热保护、过载保护和 VDD 过压保护。

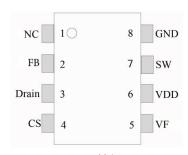
■ 典型应用

- 小家电电源
- 工业控制

■ 主要特点

- 集成9Ω, 500V MOS
- 集成 500V 高压启动电路
- 集成续流二极管
- 多模式控制、无异音工作
- 支持降压和升降压拓扑
- 默认 12V 输出 (FB 脚悬空)
- 待机功耗低于 50mW
- 良好的线性调整率和负载调整率
- 集成软启动电路
- 内部保护功能:
 - ▶ 过载保护 (OLP)
 - ▶ 逐周期电流限制 (OCP)
 - ➤ 输出过压保护 (OVP)
 - ▶ VDD 过压、欠压和电压箝位保护

■ 封装信息



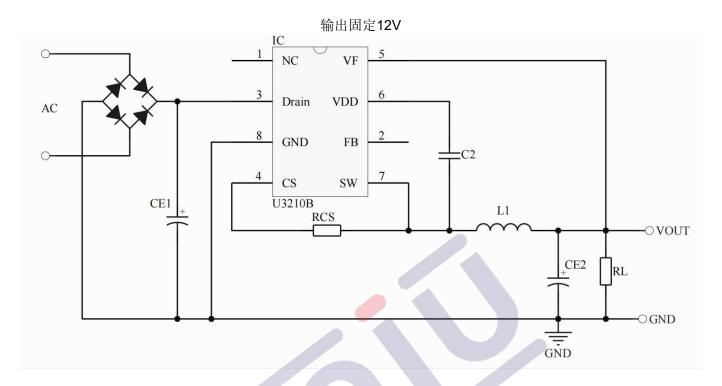
SOP-8俯视图

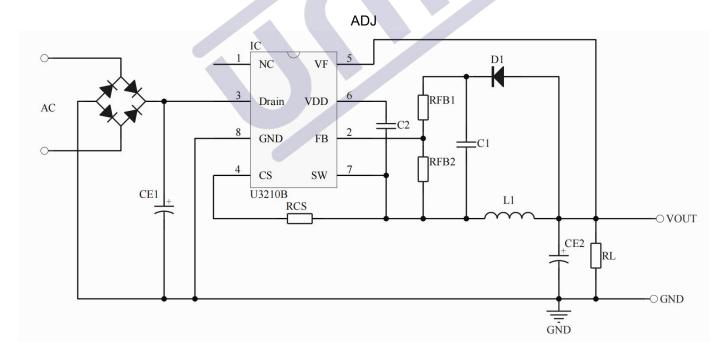
■ 应用推荐

产品型号	封装	MOS参数	输出电压	MOS IPK
U3210B	SOP-8	500V,9Ω	> 2V	0.7A

注: 1、默认降压型输出。 2、实际输出功率取决于输出电压和散热条件。

■ 典型应用电路





注: 1、典型应用电路及参数供参考,实际应用电路参数请在实测基础上设定,量产请和原厂沟通,其他不明请于我司工程师沟通联系。

■ 功能描述

U3210B系列是一款集成高压启动和供电功能的多模式 PWM 控制功率开关。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓扑电路,适用于小家电电源和线性电源 替代等场所。同时,U3210B具有输出精度高和外围成本低的特点。

● 超低静态工作电流

U3210B的静态工作电流典型值为 200uA。如此低的工作电流降低了对于 VDD 电容大小的要求,同时也可以提高系统效率。

● 高压启动电路和超低待机功耗 (<50mW)

U3210B内置有一个500V 高压启动单元。在开机过程中该启动单元开始工作,从 HV 端取电并通过高压电流源对 VDD 电容进行充电,如"功能模块"中所述。当VDD电压上升至 V_{DD_ON}(典型 7.5V)时,芯片开始工作且芯片工作电流增加至约 0.8mA。在稳态工作时,芯片通过反馈二极管由输出进行供电,同时借助高压启动电路,系统待机功耗可以低至 50mW 以下。

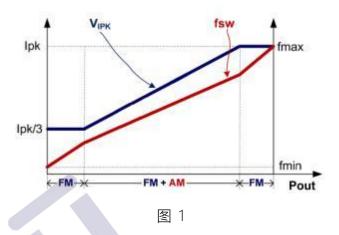
● 逐周期峰值电流限制和前沿消隐

U3210B內置的峰值电流检测阈值具有随系统工作频率变化而变化的特点,并通过 CS 管脚实现对电感峰值电流的调制。当 CS 管脚采样到的电压超过该阈值时,功率 MOSFET 立即关断直至下一开关周期开始。同时芯片内置有前沿消隐电路(消隐时间约 350ns),消隐期间内部的逐周期峰值电流比较器将被屏蔽而不能关闭 MOSFET。

● 多模式 PWM 控制

为满足系统平均效率和空载待机方面的严格要求, U3210B采用了调幅控制 (AM)和调频控制 (FM) 相结合的工作模式,如图 1 所示。

满载情况下系统工作于调频模式 (FM); 重载至轻载 阶段, 系统同时工作于调频和调幅模式 (FM+AM) 中,以达到良好的调整率和较高的系统效率; 当工作于 空载附近时,系统将重新进入调频模式以降低待机损耗。 通过这种方式,可以将系统 待机功耗降至 50mW以下。



• 软启动

U3210B内集成有 4ms (典型值)的软启动电路,在芯片启动过程中系统开关频率逐渐增加,而且每次系统的重新启动都会伴随着一次软启动过程。

● 输出过压保护 (OVP)

当在连续的 3 个工作周期里 U3210B检测到 FB 脚电压高于 2.4V 以上时,芯片将进入输出电压过压保护 (OVP),随后系统将进入自动重启模式。

● 过载保护(OLP)/短路保护(SLP)

当过流或短路情况发生时,输出电压和反馈电压将降低 且低于输出过载保护阈值VFB_OLP。如果在50ms(典型值)的时间内该状态持续存在,则芯片进入短路自锁 状态,需重新上电。

● 异常过流保护 (AOCP)

过热保护(OTP)在某些情况下(如重载或者输出短路等),系统的电感电流峰值将上升过于剧烈。为避免电感峰值电流过大对系统元器件造成损坏,芯片内部设计有异常过流检测模块(AOCP,典型阈值为0.9V)。当CS电压高于该阈值时,芯片进入降频工作状态。



● 过热保护(OTP)

U3210B内部集成的过热保护电路会检测芯片的内部结温, 当芯片结温超过150 ℃ (典型值) 时,系统进入到自动重启模式。

• 优化的动态响应

U3210B集成有快速动态影响功能,可降低负载切换时的输出电压跌落。

● 消除可闻噪音

U3210B通过采用频率调制和 CS 峰值电压调制调相结合的多模式控制方式,可实现在全负载范围内有效消除可闻噪音。

● VDD 过压保护(OVP)和 VDD 电压箝位

当 VDD 电压高于 V_{DD_OVP} (典型值25V)时,芯片将停止工作。随后 VDD 电压下降至 V_{DD_OFF} (典型值 7V)并进入重启模式。此外,芯片内部集成有 2 7 V 稳压管,避免 VDD 脚电压过高而损坏。

• 软驱动电路

U3210B内置有软驱动电路优化了系统 EMI 性能。



1、版本记录

DATE	REV.	DESCRIPTION	
2023/1/02	1.0	产品升级	
2023/8/05	1.1	参数调整	

2、免责声明

浙江宇力微新能源科技有限公司保留对本文档的更改和解释权力,不另行通知!

客户在下单前应获取我司最新版本资料,并验证相关信息是否最新和完整。量产方案需使用方自行验证并自担所有批量风险责任。未经我司授权,该文件不得私自复制和修改。

产品不断提升,以追求高品质、稳定性强、可靠性高、环保、节能、高效为目标,我司将竭诚为客户提供性价比高的系统开发方案、技术支持等更优秀的服务。

版权所有 浙江宇力微新能源科技有限公司/绍兴宇力半导体有限公司

3、联系我们

浙江宇力微新能源科技有限公司

总部地址: 绍兴市越城区斗门街道袍渎路25号中节能科创园45幢4/5楼

电话: 0575-85087896 (研发部)

传真: 0575-88125157

E-mail:htw@uni-semic.com

无锡地址:江苏省无锡市锡山区先锋中路6号中国电子(无锡)数字芯城1#综合楼503室

电话:0510-85297939

E-mail:zh@uni-semic.com

深圳地址:深圳市宝安区西乡街道南昌社区宝源路泳辉国际商务大厦410

电话: 0755-84510976

E-mail:htw@uni-semic.com

